1P050

単結晶 ELDOR 法による量子ビットモデル分子の電子-核スピン状態評価

(阪市大院理¹, 阪大院理², 阪大院基礎工³, FIRST⁴)

○田中 彩香¹, 佐藤 和信^{1,4}, 吉野 共広¹, 西田 辰介^{2,4}, 中澤 重顕^{1,4}, Robabeh Rahimi¹,
豊田 和男^{1,4}, 塩見 大輔^{1,4}, 森田 靖^{2,4}, 北川 勝浩^{3,4}, 工位 武治^{1,4}

Electron-nuclear spin state of a molecular spin qubit model as studied by single crystal ELDOR spectroscopy

(¹Graduate School of Science, Osaka City University, ²Graduate School of Science, Osaka University, ³Graduate School of Engineering Science, Osaka University, ⁴FIRST-Quantum Information Processing Project) oAyaka Tanaka¹, Kazunobu Sato^{1,4}, Tomohiro Yoshino¹, Shinsuke Nishida^{2,4}, Shigeaki Nakazawa^{1,4}, Robabeh Rahimi¹, Kazuo Toyota^{1,4}, Daisuke Shiomi^{1,4}, Yasushi Morita^{2,4}, Masahiro Kitagawa^{3,4} and Takeji Takui^{1,4}

【序論】我々は、分子スピン量子コンピュータ/量子情報処理技術 (OC/OIP) の開拓を目指し、 マイクロ波 (MW) パルスやラジオ波 (RF) パルスによる電子スピン磁気共鳴技術を用いて、 分子のスピン量子状態を人為的に制御する(スピン量子状態制御)研究を進めている。スピ ン量子ビットを用いる OC/OIP において、操作可能な核種の増加や、それに伴う制御技術の 精密化は、開発・改良の余地を多く残している。これまでに、パルス電子-核二重共鳴(ENDOR) 技術により、安定ラジカルがもつ電子スピン及び核スピンを対象に電子-核スピン系における 量子絡み合い状態の生成と検出[1-4]、電子スピン qubit の C-NOT ゲート操作[5]を行ってきた。 その中で、核スピンを操作する代わりに電子スピンを MW パルスで操作しても、電子-核スピ ン系の量子状態変換が実現できることを提案し、実証してきた[3]。分子内の各スピンを量子 ビットとして使用するためには、緩和時間内で多くの操作が必要となるため、操作時間の短 縮は重要である。高強度の RF パルスを用いたパルス ENDOR 法による核スピンの量子状態制 御と比較し、MW パルスを用いた核スピンの状態変換では、高周波数を用いる分だけ変換に かかる時間の大幅な短縮が見込めるため、メリットが大きい。また、MW パルスは高強度パ ルスであるため、gn因子の小さい核も扱うことができると期待される。今回、2種のマイクロ 波周波数を用いるパルス電子-電子二重共鳴(ELDOR)法を適用することにより、電子-核ス ピン状態の MW パルスによる状態制御技術の開発と高速制御を目的として、同位体置換ジフ ェニルニトロキシド2種(図1.分子1、2)の希釈単結晶を用いた単結晶パルス ELDOR 法に よる電子-核スピン量子状態の評価法を検討した。



図1.同位体標識ジフェニルニトロキシド分子1,2とベンゾフェノン3

【実験】実験には、窒素同位体及び重水素で部分的に標識化したジフェニルニトロキシド(分子1,2)を重水素化ベンゾフェノン単結晶(ホスト分子、3)中に希釈した混晶単結晶を育成して用いた。測定には、Bruker BioSpin 社製 Elexsys E580に、共同開発したコヒーレントデュアルマイクロ波パルス照射システムと高出力マイクロ波増幅アンプを組み込んだQバンドパルス ELDOR 分光器を使用した。結晶の角度依存性の測定には1軸ゴニオメーターを用いた。 試料の温度は、home-designedのOxford 社製 Optistat SXM クライオスタットを用いて制御した。

【結果と考察】図2に、 静磁場が結晶のb軸方 向と平行な場合に観 測された分子1のエコ 一検出磁場掃引スペ クトルと、シグナルが 観された磁場に はる、 $\pi(v_2) - \tau_1 - \pi/2$ $-\tau_2 - \pi - \tau_2 - Echo の3$ パルス系列を用いて 測定した第2マイクロ 波周波数(v_2)掃引 ELDOR スペクトルの



図 2. B₀||b 軸における分子 1 のエコー検出磁場掃引スペクトル(左)と 2D-ELDOR-NMR スペクトル(右)

磁場依存性を示した。低磁場側では低周波数側に、高磁 場側では高周波数側にシグナルが現れている。これは、 各磁場で観測している遷移のエコー強度の変化を、第2 マイクロ波パルスの周波数依存性として観測している ものであり、近傍の異なる遷移が誘起されることを示し ている。モニターする遷移、及び第2マイクロ波によっ て誘起され得る遷移を、図3に示す。¹⁵N核スピンに焦 点をあてて観測を行ったが、図2の ELDOR 効果の帰属 から、H核スピンによる分裂も観測されたことがわかっ た。一般に、H核スピンについては超微細禁制遷移の遷 移確率が小さく ELDOR 効果の観測が困難であるため、 RF と MW による ENDOR 効果と ELDOR 効果を併用す ることにより、核スピン選択的なスピン制御が期待され る。現在、角度依存性を含めて ELDOR 効果の定量的解 析を進めている。発表では、ELDOR 効果と電子-核スピ ン状態の関係を明らかにし、マイクロ波による電子-核ス ピン状態の量子状態制御について報告する。



【文献】

[1] R. Rahimi, K. Sato, T. Takui et al., Int. J. Quantum Inf., 3, pp.197-204(2005).

[2] K. Sato, R. Rahimi, T. Takui et al., Physica E, 40, pp.363-366(2007).

[3] K. Sato, S. Nakazawa, T. Takui et al., J. Mater. Chem., 19, pp.3739-3754(2009).

[4] T.Yoshino, K. Sato, T. Takui et al., J. Phys. Chem. Lett., 2, pp.449-453(2011).

[5] S. Nakazawa, S. Nishida, K. Sato, Y. Morita et al., *Angew. Chem. Int. Ed.*, **51**, pp.9860-9864 (2013).